

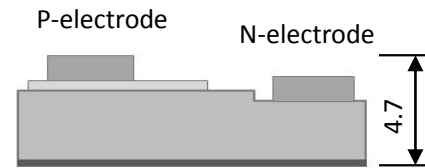
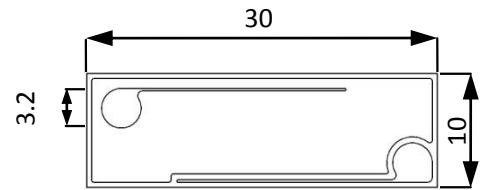
◆ 产品特点:

**.*.*.*.*30E

- 高亮度、长寿命
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好一致性
- DBR/SD 工艺

◆ 物理参数:

芯片尺寸	10mil×30mil(250±25μm×750±25μm)
芯片厚度	4.7mil (120±5μm)
焊盘尺寸	3.2mil (80±10μm) in diameter
P 电极	金
N 电极	金



Reflector 单位: mil

◆ 光电参数: (Tc=22℃, I_F=60mA)

产品型号	波长范围 (λ _D , nm)		工作电压 (V _F , V)	反向漏电流 (I _R , μA) @V _R =7V	半波宽度 (Δλ, nm)	最大电流 (I _F , mA) DC
	Min	Max				
**.*.*.*.C30E	450	452.5	≤3.4	≤1	≤30	90
**.*.*.*.D30E	452.5	455				
**.*.*.*.E30E	455	457.5				
**.*.*.*.F30E	457.5	460				
**.*.*.*.G30E	460	462.5				
**.*.*.*.H30E	462.5	465				

◆ 光强等级: (Tc=22℃, I_F=60mA)

等级	...	P78	P82	P86	P90	P94	P98	102	...
P _o (mW)	...	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	...

◆ 其他说明:

- 光电参数均系新纳晶光电测试仪器在晶圆条件下的测试数据, 99%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于 280℃, 持续时间小于 10 秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 ±0.5nm
- 可根据客户要求订做特殊规格的芯片

网址: www.nanojoin.com